

1953—1958 年

半导体科学文献索引

中国科学技术情报研究所編

科学出版社

1953—1958 年

半导体科学文献索引

中国科学技术情报研究所編

科学出版社

1962

内 容 简 介

本书收集 1953—1958 年世界各国的有关半导体科学文献的题目七千多条,是已出版的“1920—1952 年半导体科学文献索引”一书的续编。可供半导体和固体物理科学工作者参考。

1953—1958 年 半 导 体 科 学 文 献 索 引

中国科学技术情报研究所编

*

科学出版社出版 (北京朝阳门大街 117 号)
北京市书刊出版业营业登记证出字第 061 号

中国科学院印刷厂印刷 新华书店总经售

*

1962 年 9 月第 一 版	书号: 2582 字数: 727,000
1962 年 9 月第一次印刷	开本: 737×1092 1/18
(京) 0001—1,500	印张: 20 2/9

定价: 3.00 元

目 录

I. 半导体	1
一、一般問題	1
1. 材料制备	1
2. 材料及性質	8
3. 晶体結構、扩散、溶解及催化作用	21
4. 測量及实验方法	29
5. 其他	41
二、电学性質	57
1. 电子理論及能帶結構	57
2. 載流子的注入、迁移、复合及表面問題	78
3. 噪声	102
4. 电导率及其他	104
三、光学性質及光电現象	152
1. 光学性質	152
2. 激子	164
3. 輻射对半导体的影响	167
4. 光电現象	172
四、温差电、热学及磁学性質	198
II. 半导体器件及光电器件	224
一、一般問題	224
二、二极管、整流器及 $p-n$ 結	239
三、晶体管	266
1. 性質	266
2. 制造	289
3. 参数及測試	293
四、半导体电阻及光电池	301
五、光电倍增管及象加强器	324
III. 半导体器件的应用	335

I. 半 导 体

一、一 般 問 題

1. 材 料 制 备

0001 沈梅英 半导体材料——化学世界, 1956, No. 5, 234 (中文)

0002 黄楚裳 锗的提炼——化学世界, 1956, No. 8, 422—424, 425 (中文)

0003 Александров Б. Н., Веркин Б. И., Лазарев Б. Г. Получение чистых металлов методом зонной кристаллизации. I. Получение чистого олова.—Физ. металлов и металловедение, 1956, 2, № 1, 93—99 (俄文)

制备纯金属的区域结晶法. I. 纯锡的制备

0004 Алиев М. И. К методике изготовления смесей селена с различными содержаниями йода.—Азербэсане инст. сэрлэри, Тр. Азерб. индустр. ин-та, 1957, вып. 17, 116—122 (俄文)

论具有不同碘含量的硒的混合物的制备法

0005 Андриевский А. И., Мищенко М. Т. Об особенностях роста кристаллов закиси меди при высокой температуре.—Докл. львовск. политехн. ин-та, 1955, 1, № 2, 38—42 (俄文)

论在高温下氧化亚铜晶体生长的特点

0006 Бредов М. М. О возможности получения p - n перехода в германии посредством импульсного нагрева.—Ж. техн. физики, 1955, 25, № 12, 2104—2111 (俄文)

论使用脉冲加热法制取锗 p - n 结的可能性

0007 Васенин Ф. И. Очистка теллура и сурьмы.—Физ. металлов и металловедение, 1956, 3, № 2, 360—362 (俄文)

碲和锑的提纯

0008 Виноградова К. И., Галаванов В. В., Наследов Д. Н. Получение сурьмянистого индия высокой степени чистоты методом зонной плавки.—Ж. техн. физики, 1957, 27, № 9, 1976—1984 (俄文)

区域熔炼法制备高纯度锑化铟

0009 Голунова Н. А., Коломиец Б. Т. Новые стеклообразные полупроводники.—Изв. АН

СССР, сер. физ., 1956, 20, № 12, 1496—1500 (俄文)

各种新的玻璃状半导体

0010 Горюнова Н. А., Коломиец Б. Т., Шило В. П. Стеклообразные полупроводники. II. Стекло-образование в сплавах халькогенов фосфора, мышьяка, сурьмы, висмута и таллия.—Ж. техн. физ., 1958, 28, № 5, 981—985 (俄文)

玻璃状半导体. II. 磷、砷、锑、铋、铊的磷铝合金中的玻璃形成

0011 Елпатьевская О. Д. О механизме образования тонких слоев селенида и теллурида ртути.—Ж. техн. физ., 1958, 28, № 12, 2669—2675 (俄文)

关于硒化汞和碲化汞薄层形成的机构

0012 Ермаков В. С. Получение германия из золы топлива.—Теплоэнергетика, 1958, № 1, 80—81 (俄文)

从烟道灰中提取锗

0013 Изергин П. В. К вопросу о выращивании монокристаллов германия из расплава.—В сб.: Вопр. металлургии и физ. полупроводников. М., АН СССР, 1957, 47—49 (俄文)

从熔融物中拉制锗单晶的问题

0014 Иноземцева И. А. Получение кремния высокой чистоты йодидным методом.—В сб.: Вопр. металлургии и физ. полупроводников. М., АН СССР, 1957, 12—17 (俄文)

用碘化法得到高纯度硅

0015 Клешевникова С. И., Покровский Я. Е., Румянцев Е. И. Получение чистого кремния термическим разложением силана.—Ж. тех. физ., 1957, 27, № 8, 1645—1648 (俄文)

用甲硅烷热分解的方法得到纯硅

0016 Конозенко И. Д., Хайкина Р. М. По поводу письма П. А. Курова “К вопросу о структуре и свойствах слоев, получающихся при испарении InSb в вакууме”.—Ж. техн. физ., 1958, 28, № 4, 789—791 (俄文)

“关于真空中制备的 InSb 蒸发层的结构和性质

問題”給 П. А. 庫洛夫的信

- 0017 Куров П. А. К вопросу о структуре и свойствах слоев, получающихся при испарении InSb в вакууме.—Ж. техн. физики, 1957, 27, № 9, 2181—2182 (俄文)

关于在真空中蒸发 InSb 所得层的结构与特性問題

- 0018 Митренин Б. П., Трошян Н. Е., Помаев К. П., Власенко В. А., Губанов Ю. Д. Исследование возможности получения гомогенных сплавов германия с кремнием с помощью зонной плавки.—В сб.: вопр. металлургии и физ. полупроводников, М., АН СССР, 1957, 59—69 (俄文)

用区域熔炼法得到鍺和硅的均匀合金的研究

- 0019 Митренин Б. П., Лалыкин С. П., Саврасов Ю. П., Радаикин Л. К. Применение бесщелевой зонной плавки для получения монокристаллов кремния.—В сб.: Вопр. металлургии и физ. полупроводников, М., АН СССР, 1957, 35—40 (俄文)

无坩埚区域熔炼在获得硅单晶上的应用

- 0020 Митренин Б. П., Бурдиашвили Ш. С., Шамба Н. А., Волков В. П., Ковырзин В. К., Соловьев Л. К. Получение кристаллов кремния методом вытягивания из расплава.—В сб.: Вопр. металлургии и физ. полупроводников, М., АН СССР, 1957, 24—34 (俄文)

从熔化物中拉制硅晶体

- 0021 Мурач Н. Н. Кремний для полупроводников.—Природа, 1956, № 7, 82—83 (俄文)
- 半导体硅的制备

- 0022 Николаенко Г. Н. Синтез сурьмянистого алюминия (AlSb) и некоторые его свойства.—В сб.: Вопр. металлургии и физ. полупроводников, М., АН СССР, 1957, 80—90 (俄文)

鍺化鋁合金 (AlSb) 及其几种特性

- 0023 Петров Д. А. Ближайшие задачи развития металлургии полупроводников.—В сб.: Вопр. металлургии и физ. полупроводников, М., АН СССР, 1957, 5—11 (俄文)

发展半导体冶金学的目前任务

- 0024 Петров Д. А. О реальном распределении примесей в кристаллах, получаемых методом вытягивания из расплава, и о возможностях развития этого метода.—Ж. физ. химии, 1956, 30, № 1, 50—55 (俄文)

論从熔化物中用拉制法制取的晶体中杂质的实

际分布和此方法的发展条件

- 0025 Петров Д. А. Развитие исследований в области полупроводниковых материалов (Всес. совещание в Москве).—Вестн. АН СССР, 1957, № 9, 117—119 (俄文)

在半导体材料方面研究的发展情况

- 0026 Петров Д. А. Современные полупроводниковые материалы.—Изв. АН СССР, Отд. техн. н., 1956, № 11, 82—95 (俄文)

最新半导体材料

- 0027 Петров Д. А. Современные полупроводниковые материалы.—Тр. I-й Межевззовск. конференции по соврем. техн. диэлектриков и полупроводников. 1956 г. Л., 1957, 21—30 (俄文)

最新的半导体材料

- 0028 Петров Д. А., Жукова Л. К. Получение чистого кремния методом восстановления хлористого кремния цинком.—В сб.: Вопр. металлургии и физ. полупроводников, М., АН СССР, 1957, 18—23 (俄文)

用鋅还原氯化硅的方法得到純硅

- 0029 Петров Д. А., Земсков В. С. Аппаратура и методы выращивания монокристаллов полупроводников.—В сб.: Рост кристаллов, М., АН СССР, 1957, 262—272 (俄文)

半导体拉单晶的设备和方法

- 0030 Петров Д. А., Кекуа М. Г., Дашевский М. Я., Земсков В. С., Петрусевич Р. Л. Развитие работ по очистке германия методами кристаллизации и получение монокристаллов германия с равномерными свойствами по длине.—В сб.: Вопр. металлургии и физ. полупроводников, М., АН СССР, 1957, 50—58 (俄文)

用結晶的方法提純鍺的工作进展情况及制备在长度方面具有一致特性的鍺单晶

- 0031 Петров Д. А., Кекуа М. Г., Хвостикова В. Д., Шашков Ю. М., Сучкова А. Д. О получении монокристаллов кремния.—В сб.: Вопр. металлургии и физ. полупроводников, М., АН СССР, 1957, 41—46 (俄文)

关于硅单晶的获得

- 0032 Петров Д. А., Миргаловская М. С., Стрельникова И. А., Комова Э. М. Получение монокристаллов AlSb и изучение их свойств.—В сб.: Вопр. металлургии и физ. полупроводников, М., АН СССР, 1957, 70—79 (俄文)

AlSb 单晶体的制备及对其性质的研究

- 0033 Преснов В. А., Сынов В. Ф. Получение и исследование интерметаллических соединений в тонких слоях.—Ж. техн. физики, 1957, 27, No. 1, 123—126 (俄文)
金属間化合物薄层的制备和研究
- 0034 Сергеев В. М., Штрум Е. Л. Очистка пидия и получение соединения InSb с большой подвижностью электронов.—Ж. техн. физ., 1957, 27, No. 12, 2698—2701 (俄文)
銻的提純和高电子迁移率的 InSb 化合物的制备
- 0035 Хениш Полупроводниковые материалы.—Новые книги за рубежом, 1953, No. 2, 12—14 (俄文)
半导体材料
- 0036 Шевталь Н. Н. Проблемы роста кристаллов. (совещание в ин-те кристаллографии).—Вестн. АН СССР, 1956, No. 5, 96—98 (俄文)
晶体生长的问题
- 0037 Шмарцев Ю. В. Получение германия для радиотехнических полупроводниковых приборов.—В сб.: Полупроводник. приборы и их применение. Вып. 2, М., "Сов. радио", 1957, 3—5 (俄文)
用于无线工程上的半导体器件的锗的制备
- 0038 Aitchison R. E. Semiconducting materials.—Austral. J. Sci., 1954, 17, No. 2, 53—54 (英文)
半导体材料
- 0039 Andrieux Jean-Lucien, Barbier-Andrieux Marie-Jeanne, m-mc. Préparation du germanium par électrolyse ignée.—C. r. Acad. Sci. 1955, 240, No. 22, 2104—2106 (法文)
用熔融电解法制备锗
- 0040 Bădănoiu Maria. Prepararea siliciului pur în vederea studiului adaosurilor de impuritate pentru semiconductorii cu siliciu (Notă preliminară).—Studii și cercetări fiz., 1955, 6, No. 1, 98—100 (罗马尼亚文)
供研究锗半导体中的掺杂标准用的純锗的制取
- 0041 Barbier-Andrieux Marie-Jeanne. Recherches sur la préparation par électrolyse ignée du germanium et de quelques-uns de ses alliages binaires avec les métaux de transition.—These, doct. sci. phys., Fac. sci. Univ. Grenoble. Paris, Masson et cie, 1955, 53 (法文)
锗及其与过渡金属的某些二元合金的燃烧电解制备法的研究
- 0042 Barbier-Andrieux Marie-Jeanne. Sur la préparation par électrolyse ignée des alliages du germanium avec le silicium et quelques autres métalloïdes.—C. r. Acad. sci., 1956, 242, No. 19, 2352—2354 (法文)
論用燃烧电解法制备锗和硅以及其他类金属的合金
- 0043 Bennett D. C., Sawyer B. Single crystals of exceptional perfection and uniformity by zone leveling.—Bell System Techn. J., 1956, 35, No. 3, 637—660 (英文)
用区域匀平法获得超高純均匀的单晶
- 0044 Billig E. Defects in germanium crystals grown from the melt.—Brit. J. Appl. Phys., 1956, 7, No. 10, 375—376 (英文)
从熔化物生长的锗晶体中的缺陷
- 0045 Birman Joseph L. On zone refining.—J. Appl. Phys., 1955, 26, No. 10, 1195—1197 (英文)
区域提純
- 0046 Bishop M. E., Liebson S. H. Growth of cadmium sulfide crystals.—J. Appl. Phys., 1953, 24, No. 5, 660—661 (英文)
硫化镉晶体的生长
- 0047 Blodgett Katharine B. Removal of copper from germanium.—J. Appl. Phys., 1955, 26, No. 12, 1520—1521 (英文)
从锗中去除銅
- 0048 Boomgaard J. van den, Kröger F. A., Vink H. J. Zone melting of decomposing solids.—J. Electronics, 1955, 1, No. 2, 212—217 (英文)
分解固体的区域熔炼
- 0049 Bradshaw S. E., Mlavsky A. L. The control of the properties of single crystal silicon.—Rept. Meet. Semiconduct. Phys. Soc., 1956, London, s. a., 21—26 (英文)
硅单晶体性质的控制
- 0050 Buehler E. Contribution to the floating zone refining of silicon.—Rev. Scient. Instrum., 1957, 28, No. 6, 453—460 (英文)
硅的浮置区域熔炼法
- 0051 Chevigny, Roy. Fabrication et usages du germanium, silicium pur, tantale, niobium, zirconium.—Métaux (Corros.—inds.), 1954, 29, No. 345, 181—189 (法文)
锗、純硅、鈦、鉍和鎢的生产和应用

- 0052 Colombani Antoine, Huet Pierre. Errata.—C. r. Acad. sci., 1957, 244, No. 10, 1423 (法文)
对“铋薄层的制备和电学性质”一文的更正
- 0053 Davies L. W. Some metallurgy and physics of germanium.—Australas. Engr., 1955, 46, Apr. 66—71 (英文)
关于锗的某些冶金学问题和物理学问题
- 0054 Davis M., Calverly A., Lever R. F. Floating zone melting of solids by electron bombardment.—J. Appl. Phys., 1956, 27, No. 2, 195—196 (英文)
利用电子轰击的固体浮置区域熔炼
- 0055 Detwiler D. P., Fox W. M. Purification of gallium by zone-refining.—J. Metals, 1955, 7, No. 1, 205 (英文)
用区域熔炼法提纯镓
- 0056 Dobke Gunther, Koch Werner. Verfahren zum Herstellen von elektrisch unsymmetrisch leitenden Systemen.—West Germany Pat. 881973, 6.07.53 (西德专利)
具有单极传导性的半导体系统的制造方法
- 0057 Dunoyer J. M. Note à propos de l'article sur la cristallisation du germanium de Trillat, Tertian, Fourdeux.—Vide, 1957, 11, No. 66, 460—461 (法文)
评述特里耶、特提安、富德的论文“锗的结晶”
- 0058 Folberth O. G. Mischkristallbildung bei A^{III}B^V-Verbindungen.—Z. Naturforsch., 1955, 10a, No. 6, 502—503 (德文)
Ⅲ-V族化合物中混合晶体的形成
- 0059 Folberth O. G., Weiss H. Herstellung und elektrische Eigenschaften von InP und GaAs.—Z. Naturforsch., 1955, 10a, No. 8, 615—619 (德文)
InP 和 GaAs 的制备和电学性质
- 0060 Gans Francois, Lagrenaudie Jean, Seguin Paul. Sur la preparation et les proprietes d'arseniures semi-conducteurs.—C. r. Acad. sci., 1953, 237, July 27, 310—313 (法文)
论砷化物半导体的制备和性质
- 0061 Goodman C. H. L. Zone melting.—Sci. News, 1956, No. 39, 26—41 (英文)
区域熔炼
- 0062 Goorissen J. Préparation des monocristaux de silicium pur par la méthode de la zone flottante.—Acta electron., 1956, 1, No. 4, 201—206 (法文)
纯硅单晶的浮置区域熔制备法
- 0063 Gremmelmaier R. Herstellung von InAs- und GaAs-Einkristallen.—Z. Naturforsch., 1956, 11a, No. 6, 511—513 (德文)
InAs 和 GaAs 单晶体的制备
- 0064 Gremmelmaier R., Madelung C. Herstellung von Einkristallen der Halbleitenden Verbindung vom Typus A^{III}B^V.—Z. Naturforsch., 1953, 8a, No. 5, 333 (德文)
A^{III}B^V 型半导体合金单晶体的制备
- 0065 Günther K. G. Aufdampfschichten aus halbleitenden III-V-Verbindungen. — Naturwissenschaften, 1958, 45, No. 17, 415—416 (德文)
以冷凝蒸汽法制备的 Ⅲ-V 族元素的半导体化合物层
- 0066 Hall R. N. Segregation of impurities during the growth of germanium and silicon crystals.—J. Phys. Chem., 1953, 57, No. 8, 836—839 (英文)
在锗和硅晶体生长时杂质之分凝
- 0067 Hartman D. K., Ostapovich P. L. Processing and purification of silicon for semiconductor use.—Metal Progr., 1956, 70, No. 4, 100—103 (英文)
半导体器件用硅的制备与提纯
- 0068 Hatschek R. L. Zone melting purifies germanium.—Iron Age, 1954, 173, No. 10, 78 (英文)
用区域熔炼法提纯锗
- 0069 Heywang W. Zur Stabilität senkrechter Schmetzzonen.—Z. Naturforsch., 1956, 11a, No. 3, 238—243 (德文)
垂直区域熔融物的稳定性
- 0070 Hulme K. F., Mullin J. B. The role of evaporation in zone melting indium antimonide.—J. Electron and Control, 1957, 3, No. 2, 160—170 (英文)
在区域熔炼砷化铟中蒸发所起的作用
- 0071 Isery H. Herstellung von Germaniumeinkristallen.—Wiss. und Fortschr., 1956, 6, No. 2, 41—44 (德文)
锗单晶体的制备
- 0072 James E. (General Electric Co. Ltd.). Methods of preparing single crystals of semiconducting materials.—Brit. Pat. 723,179, 2.02.55 (英国专利)
半导体材料单晶体的制备法
- 0073 Jones R. H. The effect of oxygen on an evaporated PbSe layer.—Proc. Phys. Soc., 1957, 70, No. 7, 704—708 (英文)
氧气对蒸发制备的 PbSe 层的作用

- 0074 Kaiser W., Keck P. H. Oxygen content of silicon single crystals.—J. Appl. Phys., 1957, **28**, No. 8, 882—887 (英文)
硅单晶的含氧量
- 0075 Kamecki J., Sędzimir J., Zembura Z. Metalurgia i własności germanu.—Hutnik (Stalinogrod), 1955, **22**, No. 1, 6—8 (波兰文)
锗的冶金学和性质
- 0076 Kamiński Aleksy. Otrzymywanie krzemu o wysokiej czystości.—Elektronika, 1955, **1**, No. 1—2, 11—19 (波兰文)
高纯度硅的制作
- 0077 Keck Paul H. Floating zone crystallization of silicon.—Physica, 1954, **20**, No. 11, 1059—1065 (英文)
硅的浮置区熔结晶
- 0078 Kleinknecht H. Herstellung und Eigenschaften von Einkristallen und *p-n*-Schichtkristallen aus Silizium.—Z. Vereines Dtsch. Ingr., 1954, **96**, No. 1, 30 (德文)
硅单晶及其 *p-n* 晶体的制备和性质
- 0079 Kretschmar G. G., Schilberg L. E. Preparation and photoconductive properties of cadmium telluride films.—J. Appl. Phys., 1957, **28**, No. 8, 865—867 (英文)
碲化镉薄膜的制备和光电导性
- 0080 Kröger F. A., Nobel D. de. Preparation and electrical properties of CdTe single crystals.—J. Electronics, 1955, **1**, No. 2, 190—202 (英文)
CdTe 单晶的制备和电学性质
- 0081 Kurtz A. D., Kulin S. A. Effects of growth rate on crystal perfection and lifetime in germanium.—J. Appl. Phys., 1956, **27**, No. 11, 1287—1290 (英文)
生长速度对锗晶体的完美与寿命的影响
- 0082 Lagrenaudie J. Étude de P_2Zn_3 cristallisé aux basses températures.—J. phys. et radium, 1956, **17**, No. 4, 359—362 (法文)
在低温下结晶的 P_2Zn_3 的研究
- 0083 Lehovec K., Soled J., Koch R., MacDonald A., Stearns C. Apparatus for crystal pulling in vacuum using a graphite resistance furnace.—Rev. Scient. Instrum., 1953, **24**, No. 8, 652—655 (英文)
利用石墨电炉在真空中拉晶的装置
- 0084 Mataré H. F. Zur Herstellung hochreiner Germanium- und Silizium-Kristalle.—Elektron. Rundschau, 1957, **11**, No. 10, 293—296 (德文)
超高纯度锗、硅晶体的制备
- 0085 Mercier J. M. La technologie du germanium.—Onde électr., 1954, **34**, No. 328, 559—572 (法文)
锗的制造法
- 0086 Mercier J. M., Pistoulet Bernard. La technologie du germanium.—Bull. Soc. franc. électriciens, 1954, **4**, No. 47, 629—648 (法文)
锗的制造法
- 0087 Morin Francis J. Method and means for controlling the resistance of oxidic semiconductors.—Canada Pat. 496892, 13.10.53 (加拿大专利)
控制氧化物半导体的电阻的方法及其意义
- 0088 Niimi T., Baba H., Ogawa N., Furusho K., Tadachi C. Processes of preparation of germanium single crystals.—Repts Electr. Commun. Lab., Nippon Telgr. and Teleph. Public Corp., 1957, **5**, No. 5, 5—9 (英文)
锗单晶的制备过程
- 0089 Paszkowski B., Sołtys Z., Gafda A. O próżniowym wytopie krzemu.—Arch. elektrotechniki, 1953, **2**, No. 3—4, 323—325 (波兰文)
锗在真空中的熔化
- 0090 Pfann W. G. Redistribution of solutes by formation and solidification of a molten zone.—J. Metals, 1954, **6**, No. 2, 294—297 (英文)
熔区形成和凝固时溶质的再分布
- 0091 Pfann W. G., Olsen K. M. Purification and prevention of segregation in single crystals of germanium.—Phys. Rev., 1953, **89**, No. 1, 322—323 (英文)
锗单晶的提纯和分凝的防止
- 0092 Rodot Michel, Duclos Pierre, Kover Francois, Rodot Huguettem-me. Préparation d'antimoniure d'indium. Détermination des masses efficaces.—C. r. Acad. sci., 1956, **242**, No. 21, 2522—2525 (法文)
碲化铟的制备。有效质量的测定
- 0093 Rubesh E. Получение ориентированных кристаллов германия методом контакта.—Ж. техн. физ., 1957, **27**, No. 8, 1655—1660 (俄文)
以接触法制备有取向的锗晶体

0094 Rubin Bernard, Moates Guy H., Weiner Joseph R. Transistor-grade silicon. I. The preparation of ultrapure silicon tetraiodide.—J. Electrochem. Soc., 1957, **104**, No. 11, 656—660 (英文)

供制备晶体管用的硅. I. 超純四碘化硅的制备

0095 Runyan W. R. Growth of large diameter silicon and germanium single crystals.—J. Appl. Phys., 1956, **27**, No. 12, 1562 (英文)

大直径硅单晶与锗单晶的生长

0096 Sangster R. C., Carman J. N. Jr. Contraction of germanium on melting.—J. Chem. Phys., 1955, **23**, No. 1, 206—207 (英文)

锗在熔融时的收缩

0097 Sangster R. C., Maverick E. F., Croutch M. L. Growth of silicon crystals by a vapor phase pyrolytic deposition method.—J. Electrochem. Soc., 1957, **104**, No. 5, 317—319 (英文)

利用汽相热解沉积法的硅晶体的生长

0098 Scanlon W. W., Brebrick R. F. The preparation and electrical properties of lead sulfide crystals.—Physica, 1954, **20**, No. 11, 1090—1092 (英文)

硫化鉛晶体的制备和电学性质

0099 Schell Hans Achim Einkristalle und p - n -Schichtkristalle aus Aluminiumantimonid.—Z. Metallkunde, 1958, **49**, No. 3, 140—144 (德文)

鋁化鋁单晶及 p - n 結

0100 Schöne E. Über die Herstellung von Germaniumeinkristallen für Dioden-und Transistorenzwecke.—Nachrichtentechnik, 1955, **5**, No. 8, 373—374 (德文)

供二极管及晶体管用的锗单晶的制备

0101 Shaw William C., Hudson D. E., Danielson G. C. Preparation of microscopic crystals for electrical measurements.—Rev. Scient. Instrum., 1955, **26**, No. 2, 237—238 (英文)

电学测量用的显微晶体的制备

0102 Šmirous Karel. Způsoby přípravy polovodičů typu A^{IV} a A^{III} B^V.—Českosl. časop. fys., 1955, **5**, No. 1, 86—95 (捷克文)

A^{IV} 与 A^{III} B^V 型半导体的制备法

0103 Speight E. A., Carasso J. I. The transistor. Part 3. Material aspects: the production of transistor grade germanium.—P. O. Electr. Engrs. J., 1954, **47**, No. 3, 166—169 (英文)

晶体管. III. 材料方面: 晶体管用锗的生产

0104 Sugaike Suezō. Synthesis, crystal lattices and some electrical properties of indium tellurides and selenides.—Mineral, 1957, **2**, No. 2, 63—77 (英文)

碲化銲和硒化銲的合成. 晶格及一些电学性质

0105 Trousil Zdeněk. Oborudovanie dla laboratorného poľučenia kryštálov germania.—Čechosl. fyz. ž., 1956, **6**, No. 1, 91—94 (俄文)

供实验室制取锗晶体用的设备

0106 Trousil Zdeněk. Die Technik des Eintragens und der Extraction einiger Metalle in die Kristallgitter des Germaniums.—Českosl. časop. fys., 1954, **4**, No. 2, 251 (德文)

在锗晶格中掺入和取出某些金属的技术

0107 Trousil Zdeněk. Technika vnášení některých kovů do krystalů germania a extrakce z nich.—Českosl. časop. fys., 1954, **4**, No. 4, 472—473 (捷克文)

锗晶体的掺杂和提纯技术

0108 Trousil Zdeněk. Zařízení k laboratorní přípravě germaniových krystalů.—Českosl. časop. fys., 1955, **5**, No. 5, 568—571 (捷克文)

供实验室制备锗晶体用的装置

0109 Weid el Joachim. Reinste und Antimondotierte Tellur-Einkristalle nach dem Czochralski-Verfahren. Ihr elektrischer Leitungsmechanismus insbesondere im Kontaky mit Metallen.—Diss., Dokt. Naturwiss., Techn. Hochsch. Stuttgart., 1956, 91 S. (德文)

按切克拉斯基法取得純淨的和掺杂的 单晶碲. 与金属接触时它們的导电机构

0110 Weisberg L. R., Gunther-Mohr G. R. Radiant energy heater.—Rev. Scient. Instrum., 1955, **26**, No. 9, 896 (英文)

輻射能发热器

0111 Fremgangsmåde til fremstilling af siliciumkrytaller til krystalensrettere.—The General Electric Co. Ltd., Denmark, Pat. 76206, 10.08.53 (丹麦专利)

晶体检波器的硅晶体的生产方法

0112 Germanium purification.—Tele-Tech., 1954, **13**, No. 4, 71 (英文)

锗的提純

0113 Herstellung von Germanium-Einkristallen. —Funk und Ton, 1953, **7**, No. 4, 218—219 (德文)

锗单晶的制造

0114 Methods and apparatus for producing germanium crystals.—British Pat. 706,849, 07.04.54 (英国专利)

生产锗晶体的方法和仪器

- 0115 Neues Herstellungsverfahren für Germanium.—
Funk-Technik, 1953, 8, No. 19, 614 (德文)
锗的新制备法
- 0116 New zone-melting process developed at Bell labs
refines materials to almost perfect purity; valuable
aid in production of transistor.—Telecommun.
Repts., 1954, 20, No. 22, 12 (英文)
貝耳電話實驗室試驗成功的能使原材料达到极
高純度的新的区域熔炼法; 晶体管生产上的一个
有力的手段
- 0117 Pour un silicium sans bore.—La Nature, 1957,
No. 3268, 327 (法文)
无硼的硅的提純法
- 0118 The production of germanium.—Chem. Age,
1953, 69, No. 1779, 307—310 (英文)
锗的生产
- 0119 Production of germanium from liquid waste.—
Erda, 1953, 25, No. 6, 37 (英文)
从生产煤气的液体残渣中提炼锗
- 0120 Semiconductor manufacture—controlling the in-
finitesimal.—Westinghouse Engr., 1954, 14, No. 5,
182 (英文)
半导体的制造—控制极小值
- 0121 Zone melting apparatus.—J. Franklin Inst., 1955,
259, No. 6, 529—530 (英文)
区域熔炼装置
- 0122 Zone melting apparatus for production of high
purity materials.—Engineer, 1956, 201, No. 5220,
209 (英文)
生产高純度材料用的区域熔炼装置
- 0123 上田 ゲルマニウム単結晶。——日立評
論, 1957, 39, No. 5, 595—600 (日文)
锗单晶制备
- 0124 木村尙 ゲルマニウムの焼結につい
て。——日本金属学会志, 1955, 19, No. 10,
567—571 (日文)
关于锗的燒結
- 0125 犬塚英夫、高林眞 トランジスタ材料の
精制。——电气通信学会杂志, 1956, 39, No.
4, 273—283 (日文)
晶体管材料的提純
- 0126 井見、馬場、小川、古上、田立 锗单晶的
制备。——电研月报, 1956, 9, No. 11, 452
—462 (日文)
- 0127 安達芳夫、后川昭雄 ゲルマニウムの精
制と単結晶生成。——生产研究, 1955, 7,
No. 10, 15—18 (日文)
锗的提純和单晶的生成
- 0128 金井康夫 带熔融法による InSb 精
制。——应用物理, 1957, 26, No. 11, 586
—588 (日文)
InSb 的区域提純
- 0129 松浦悦之 ゲルマニウムの精制と格子欠
陥。——电子工业, 1956, 5, No. 9, 15—19
(日文)
锗的提純及其晶格缺陷
- 0130 菊池誠 ゲルマニウム単結晶を作る試み。
——电气試験所彙報, 1955, 19, No. 8, 621
—630 (日文)
锗单晶体的試制。I
- 0131 菊池誠 ゲルマニウム単結晶を作る試
み。II。續報。——电气試験所彙報, 1955,
19, No. 9, 695—699 (日文)
锗单晶体的試制。II
- 0132 菊池誠 ゲルマニウムの zone refining。
——电气試験所彙報, 1956, 20, No. 6, 52
—60, 76 (日文)
锗的区域提純
- 0133 菊池誠 ゲルマニウムの zone-levelling。
——电气試験所彙報, 1956, 20, No. 7, 541
—542, 554 (日文)
锗的区域匀平
- 0134 新美达也 トランジスタ材料の精制と単
結晶。——电气学会杂志, 1956, 76, No. 2,
158—167 (日文)
晶体管材料的提純及单晶制备
- 0135 徳永惇 金属ゲルマニウムの制鍊。——
电子工业, 1956, 5, 増刊 94—95 (日文)
金属锗的精制
- 0136 稻垣胜 ゲルマニウムの製造法。——金
属, 53, 23, No. 3, 226 (日文)
锗的製造法
- 0137 ゲルマニウム単結晶の制作。——学界时
报, 53, No. 6, 670 (日文)
锗单晶的制造
- 0138 純シリコンの新しい製造法。——金属,
1957, 7, No. 10, 844 (日文)
純硅的新製造法

0139 高純度シリコンの制法。——化学工業資料, 57, 25, 77 (日文)
純硅的制法

2. 材料及性質

0140 Абрикосов Н. Х. Полупроводниковые соединения и твердые растворы в металлических системах.—Сб. тр. Воронежск. отд. Всес. хим. о-ва им. Д. И. Менделеева, 1957, вып. I, 75—83 (俄文)

金属系的半导体化合物和固溶体

0141 Бачковский и Бубакова Совершенно кристаллов германия.—Чехосл. физ. ж., 1957, 7, No. 1, 124 (俄文)

锗晶体的完善

0142 Валеев Х. С., Машкович М. Д. Нелинейные полупроводники на основе $ZnO-TiO_2$. —Ж. техн. физ., 1957, 27, No. 8, 1649—1651 (俄文)

以 $ZnO-TiO_2$ 为主的非线性半导体

0143 Валеев Х. С., Машкович В. Д. Нелинейные керамические полупроводники на основе $ZnO-TiO_2$.—В сб.: Применение полупроводников в электротехн. Л., 1958, 115—123 (俄文)

以 $ZnO-TiO_2$ 为主的非线性陶瓷半导体

0144 Вартанян А. Т. Полупроводниковые процессы в слоях органических красителях.—Изв. АН СССР, сер. физ., 1957, 21, № 4, 523—524, дискус. 524 (俄文)

在有机染料层中的半导体过程

0145 Волькенштейн Ф. Ф. Активированная адсорбция на полупроводниках.—Успехи физ. наук, 1953, 50, No. 2, 253 (俄文)

半导体的激活吸附

0146 Глазов В. М., Мяргаловская М. С. Новые полупроводниковые материалы со структурой халькопирита.—Изв. АН СССР, Отд. техн. н., 1957, No. 10, 68—70 (俄文)

具有黄铜矿型结构的新的半导体材料

0147 Горак, Маховец, Косек Теллурид цинка —полупроводниковое соединение.—Чехосл. физ. ж., 1957, 7, No. 4, 468—475 (俄文)

碲化锌——半导体化合物

0148 Горюнова Н. А., Коломиец Б. Т. Стеклообразные полупроводники.—В сб.: Вопр.

металлургии и физ. полупроводников, М., АН СССР, 1957, 110—120 (俄文)

玻璃状半导体

0149 Давыдов В. И., Диев Н. П. О сублимации моносulfида германия.—Ж. неорганической химии, 1957, 2, No. 9, 2003—2006 (俄文)

論—硫化锗的升华

0150 Жузе В. П., Сергеев В. М. Полупроводниковые соединения с общей формулой ABX_2 . —Ж. техн. физ., 1958, 28, No. 10, 2093—2108 (俄文)

具有一般公式 ABX_2 的半导体化合物

0151 Жузе В. П., Сергеева В. М., Штрум Е. Л. Новые полупроводниковые соединения.—Ж. техн. физ., 1958, 28, No. 2, 233—236 (俄文)

新半导体化合物

0152 Зубин-Ивановский В. П. Исследование свойств полупроводника PbS как преобразователя при динамических измерениях.—Авторф. дисс. канд. техн. н., Воен.-инж. акад. им. В. В. Куйбышева, М., 1957 (俄文)

根据动态测量对作为转换器的 PbS 半导体性质的研究

0153 Кикоин А. К., Федороф Г. Д. Исследование тонких пленок интерметаллических соединений.—Докл. АН СССР, нов. сер., 1953, 92, No. 6, 1163 (俄文)

金属间化合物薄膜的研究

0154 Клиггер М. И. К вопросу о низкотемпературных аномалиях в примесных полупроводниках. I, II.—Ж. техн. физики, 1957, 27, No. 8, 1915—1919, 1919—1922 (俄文)

杂质半导体中的低温反常现象问题. I, II

0155 Нарита Ш. Интерпретация нейбуrowsкой теории для BaO с точки зрения сосуществования различных примесных уровней.—Пробл. соврем. физики. Сб. перев. и обз. ин. период. лит., 1954, No. 3, 28—35 (俄文)

以各种杂质共存的观点来说明 BaO 的森普尔理论

0156 Наследов Д. Н., Патракова А. Я., Шаренков В. В. Травитель для арсенида галлия.—Ж. техн. физ., 1958, 28, No. 4, 779—781 (俄文)

砷化镓的腐蚀剂

- 0157 Тронеv В. Г., Чибирева М. Е. О летучести германия в токе газов.—Ж. неорганической химии, 1956, 1, No. 10, 2278—2282 (俄文)
論鍺在气流中的揮发性
- 0158 Фань Валентные полупроводники—германий и кремний.—Успехи физ. наук, 1958, 64, No. 4, 733—799, No. 1, 111—132 (俄文)
共价半导体——鍺和硅
- 0159 Хохель С. Г. Деякі питання технології виготовлення інтерметалічної сполуки пинк-сурма.—Наук. зап. Кам'янець-Подільськ. держ. пед. ін-т, 1956, 2, 47—52 (乌克兰文)
制备鋅錫金属間化合物的几个問題
- 0160 Шапиро И. П. К вопросу о термической обработке селена.—Уч. зап. Белорус. ун-та, 1954, No. 19, 116—121 (俄文)
論硒的热处理
- 0161 Элькин В. И. О новых травителях для кремния и германия.—В сб.: Вопр. металлургии и физ. полупроводников, М., АН СССР, 1957, 142—151 (俄文)
用于鍺和硅的新腐蝕剂
- 0162 Сялят — неметаллический токопроводящий материал.—Немецкий экспорт (Берлин), 1953, No. 6, 26—27 (俄文)
硅合金——非金属导电材料
- 0163 Ainsworth L. Single crystal bismuth telluride.—Proc. Phys. Soc., 1956, 69, No. 6, 606—612 (英文)
碲化鉍单晶体
- 0164 Andersen Holger C. High purity silicon.—J. Electrochem. Soc., 1954, 101, No. 6, 287—292 (英文)
高純度硅
- 0165 Antes Leland L. Progress in cadmium sulfide.—IRE Trans. Component Parts, 1957, 4, No. 4, 129—132 (英文)
硫化镉研究的进展
- 0166 Appel J. Experimenteller Nachweis des Halbleitercharakters der Verbindungen CdTe und In_2Te_3 .—Z. Naturforsch., 1954, 9a, No. 3, 265—267 (德文)
CdTe 和 In_2Te_3 化合物的半导体性质的实验证据
- 0167 Auleytner J., Godwood K. Observations on etching of germanium crystals.—Bull. Acad. polon. sci., 1957, Cl. 3, 5, No. 6, 639—642 (英文)
鍺晶体的侵蝕的觀測
- 0168 Austin I. G., Goodman G. H. L., Pengelly, A. E. New semiconductors with the chalcopyrite structure.—J. Electrochem. Soc., 1956, 103, No. 11, 609—610 (英文)
具有黃銅矿結構的新型半导体
- 0169 Bačkovský Jindřich, Bubáková Růžena Dokonalost krystalů germania.—Českosl. časop. fys., 1957, 7, No. 1, 110 (捷克文)
晶体鍺的完善
- 0170 Bardsley W., Bell R. L. Etch pits in indium antimonide.—J. Electro. and Control, 1957, 3, No. 1, 103—105 (英文)
銻化銦中的侵蝕陷斑
- 0171 Bardsley W., Bell R. L. Slip in germanium.—Acta Metallurgica, 1956, 4, No. 4, 445—446 (英文)
鍺中的滑移
- 0172 Bardsley W., Straughan B. W. Spiral etch pits in silicon.—J. Electronics, 1956, 1, No. 5, 561—562 (英文)
硅的螺旋状侵蝕陷斑
- 0173 Baronetzky E. Zur Kenntnis der Germaniumchloride.—Diss. Technische Hochschule, Aachen, 1953.—Z. Vereines dtsh. Ingr., 1953, 95, No. 23, 799 (德文)
氯化鍺某些性质的研究
- 0174 Bastin J. A., Wright R. W. Heat treatment of polycrystalline cadmium oxide.—Proc. Phys. Soc., 1958, 72, No. 1, 65—69 (英文)
多晶氧化镉的热处理
- 0175 Batterman Boris W. Hillocks, pits, and etch rate in germanium crystals.—J. Appl. Phys., 1957, 28, No. 11, 1236—1241 (英文)
鍺晶体的陷斑和腐蝕率
- 0176 Baynton P. L., Rawson H. S., Stanworth J. E. Semiconducting properties of some vanadate glasses.—J. Electrochem. Soc., 1957, 104, No. 4, 237—240 (英文)
一些钒酸盐玻璃的半导性质
- 0177 Benda H. Ein volumeneffekt beim Ätzen von Silicium-Einkristallen.—Z. Naturforsch., 1958, 13a, No. 4, 354—355 (德文)
硅单晶体腐蝕时的体效应

0178 Bévillard Pierre Réactifs et complexes organo-métalliques du germanium.—C. r. Acad. sci., 1954, 239, No. 1, 59—61 (法文)

锗的有机-金属络合物和试剂

0179 Billing E., Dowd J. J. *p-n* junction revealed by electrolytic etching.—Nature, 1953, 172, No. 4368, 115 (英文)

用电解腐蚀法显示 *p-n* 结

0180 Blanchard Marie-Louise. La semiconductivité l'oxyde de zinc et la spectroscopie hertzienne.—Peintures, pigments, vernis, 1958, 34, No. 5, 214—217 (法文)

ZnO 半导体性质的射频频谱研究

0181 Blanchard Marrie-Louise, Le Bot Jean Corneteau Henri. Sur l'observation aux tres basses temperatures d'une bande d'absorption Deybe dipolaire de l'oxyde de zinc (énergie d'activation voisine de 0.05 eV).—J. phys. et radium, 1956, 17, 5, 451 (法文)

論在极低温度条件下对氧化锌中德拜偶极吸收带的观察(激活能在 0.05 电子伏左右)

0182 Blatt F. J. Ultrasonic attenuation in germanium and silicon.—Phys. Rev., 1957, 105, No. 3, 1118—1119 (英文)

锗与硅中的超声衰减

0183 Bloem J. Physisch chemische eigenschappen van loodsulfide in verband met afwijkingen van de stoichiometrie.—Chem. weekbl., 1955, 51, No. 22, 387—391 (荷兰文)

与化学计量学误差有关的硫化铅的物理化学性质

0184 Bogdanowicz Jerzy, Cisak Andrzej. Związki miedzymetaliczne — nowe materialy tranzystorowe.—Postepy diz., 1955, 6, No. 2, 209—234 (波兰文)

金属间化合物——半导体三极管的新材料

0185 Bohrer J. J. Organic semiconductors.—Trans. N. Y. Acad. Sci., 1958, 20, No. 5, 367—382 (英文)

有机半导体

0186 Boros J., Jeszenszky B. Halbleitereigenschaften von V_2O_5 —Festkörperphysik und Physik Leuchtstoffe. Berlin, Akad.-Verl., 1958, 117—120 (德文)

V_2O_5 的半导体性质

0187 Bösenberg Wolfram Kokillenguss von dünnen einkristallinen Germanium-Platten.—Z. angew. Phys., 1957, 9, No. 7, 347—349 (德文)

薄单晶 Ge 片的鑄件

0188 Bosenberg Wolfram. Über das Tiegelproblem bei Langzeitgluhung von Germanium.—Z. angew. Phys., 1956, 8, No. 11, 551—552 (德文)

关于锗的长时间高温处理过程中的坩埚材料选择问题

0189 Bradshaw S. E., Mlavsky A. I. The evaporation of impurities from silicon.—J. Electronics, 1956, 2, No. 2, 134—144 (英文)

硅中杂质的蒸发

0190 Brandshaw S. E. Phenomena observed in the melting and solidification of germanium.—J. Electrochem. Soc., 1954, 101, No. 5, 293—297 (英文)

在锗的凝固和熔化中观察到的现象

0191 Brebrick R. F., Scanlon W. W. Chemical etches and etch pit patterns on PbS crystals.—J. Chem. Phys., 1957, 27, No. 3, 607—609 (英文)

PbS 晶体的化学腐蚀及腐蚀斑纹

0192 Breckenridge R. G. Semiconducting intermetallic compounds.—Phys. Rev., 1953, 90, No. 3, 488—489 (英文)

半导体金属间化合物

0193 Breckenridge R. G., Blunt R. F., Hosler W. R., Frederikse H. P. R., Becker J. H., Oshinsky W. On the intermetallic compounds Indium antimonide, gallium antimonide and aluminium antimonide.—Physica, 1954, 20, No. 11, 1073—1076 (英文)

論金屬間化合物銻化銦、銻化鎵和銻化鋁

0194 Brentano J. C. M., Richards J. D. Evaporated multiple layers with semiconductor properties.—Phys. Rev., 1954, 95, No. 3, 841—843 (英文)

具有半导体性质的多重蒸发层

0195 Brice J. C., Newman P. C., Wright H. C. The indium-selenium system.—Brit. J. Appl. Phys., 1958, 9, No. 3, 110—111 (英文)

In-Se 系

0196 Bridgers Henry E. Single-crystal germanium. A modern semiconductor.—Chem. and Engen News, 1956, 34, No. 3, 220—223 (英文)

单晶锗。现代化半导体

0197 Bridger Henry E., Kolb E. D. Distribution coefficient of boron in germanium.—J. Chem. Phys., 1956, 25, No. 4, 648—650 (英文)

硼在锗中的分布系数

- 0198 Bridgers H. E., Kolb E. D. Rate-grown germanium crystals for high-frequency transistors.—J. Appl. Phys., 1955, **26**, No. 9, 1188—1189 (英文)
供高频半导体三极管用的变速生长的锗晶体
- 0199 Brockhouse B. N., Iyengar P. K. Normal vibrations of germanium by neutron spectrometry.—Phys. Rev., 1957, **108**, No. 3, 894—895, (英文)
用中子光谱术测定锗的正常振动
- 0200 Buck T. M., McKim F. S. Depth of surface damage due to abrasion on germanium.—J. Electrochem. Soc., 1956, **103**, No. 11, 597—600 (英文)
由于在锗上腐蚀引起的表面破坏的深度
- 0201 Burton J. A. Impurity centers in Ge and Si.—Physica, 1954, **20**, No. 11, 845—854 (英文)
锗和硅中的杂质中心
- 0202 Busch G., Hulliger F. Halbleitende Verbindungen mit Übergangselementen.—Helv. phys. acta, 1958, **31**, No. 4, 301—302 (德文)
过渡元素的半导体化合物
- 0203 Busch G., Mooser E., Pearson W. B. Neue halbleitende Verbindungen mit diamantähnlicher Struktur.—Helv. phys. acta, 1956, **29**, No. 3, 192—193 (德文)
具有金刚石类型结构的新的半导体化合物
- 0204 Buttler W. M., Muscheid W. Die Bedeutung des elektrischen Kontaktes bei Untersuchungen an Kadmiumsulfid-Ein-Kristallen.—Ann. Physik, 1954, **14**, No. 3—5, 215—219 (德文)
在研究硫化镉单晶体时电接触的意义
- 0205 Camp Paul R. A study of the etching rate of single-crystal germanium.—J. Electrochem Soc., 1955, **102**, No. 10, 586—593 (英文)
单晶锗的腐蚀速率的研究
- 0206 Collins C. B., Carlson R. O. Properties of silicon doped with iron or copper.—Phys. Rev., 1957, **108**, No. 6, 1409—1414 (英文)
掺有铜或铁的硅的性质
- 0207 Collins C. B., Carlson R. O., Gallagher C. J. Properties of gold-doped silicon.—Phys. Rev., 1957, **105**, No. 4, 1168—1173 (英文)
掺金硅的性质
- 0208 Colombani Antonine, Launay Jacques. Resultats theoriques concernant les couches minces d'antimoine d'indium.—C. r. Acad. sci., 1957, **245**, No. 19, 1607—1608 (法文)
有关碲化铟薄层的理论结果
- 0209 Conwell E. M. Properties of silicon and germanium: II.—Proc. IRE, 1958, **46**, No. 6, 1281—1300 (英文)
硅和锗的性质。
- 0210 Cunnell F. A., Saker E. W., Edmond J. T. A note on the semiconducting compound InSb.—Proc. Phys. Soc., 1953, **B66**, No. 2, 1115—1116 (英文)
有关半导体化合物 InSb 的评述
- 0211 Danforth W. E. Polarization and electrolysis in thorium oxide crystals.—J. Franklin Inst., 1954, **258**, No. 3, 233 (英文)
氧化钍晶体的极化和电解
- 0212 Danforth W. E. Polarization in thorium oxide crystals.—J. Chem. Phys., 1955, **23**, No. 3, 591—592 (英文)
氧化钍晶体中的极化
- 0213 Das Gupta A. K., Nair C. K. N. Polarographic reduction of germanium.—Analyt. chim. acta, 1953, **9**, No. 3, 287—291 (英文)
锗的极谱还原
- 0214 Das J. N. Study of the semiconducting properties of pyrolusite.—Z. Phys., 1958, **151**, No. 3, 345—350 (英文)
软锰矿的半导体性质的探讨
- 0215 Demontvignier M. Les semiconducteurs considérés comme des milieux ionisés.—Rev. gén. électr., 1957, **66**, No. 10, 495—512 (法文)
被看作为离子化媒质的半导体
- 0216 Déri Márta, Millner József. Vasoxid alapú, spinell-szerkezetű félvezetők.—Építőanyag, 1954, **6**, No. 4, 109—117 (匈牙利文)
具有氧化铁尖晶石结构的半导体
- 0217 Dewald J. F. The kinetics and mechanism of formation of anode films on single-crystals InSb.—J. Electrochem. Soc., 1957, **104**, No. 4, 244—251 (英文)
阳极膜在单晶 InSb 上的形成的动力学与机构
- 0218 Dillon J. A. Jr., Farnsworth H. E. Work-Function studies of germanium crystals cleaned by

- ion bombardment.—J. Appl. Phys., 1957, 28, No. 1, 174—189 (英文)
被离子轰击所清洗的锗晶体的功函数的研究
- 0219 Dixit K. R. Semi-conducting cuprous oxide.—Proc. Indian Sci. Congr. Assoc., 1957, Session 44th, Part 2, Calcutta (1957), 51—60 (英文)
半导性氧化亚铜
- 0220 Dixit K. R., Agashe V. V. Crystal structure and magnetic susceptibility of rectifying cuprous oxides.—Indian J. Phys., 1957, 31, No. 9, 466—482 (英文)
整流氧化亚铜的晶体结构和磁化率
- 0221 Douglas R. W., Goodman C. H. L. New semiconductors.—G. E. C. Journal, 1954, 21, No. 4, 215—220 (英文)
新半导体
- 0222 Ducrocq Albert. Les silicones.—Electronique, 1953, No. 76, 17—18, 23 (法文)
聚硅氧(一种塑胶)
- 0223 Dunitz J. D., Orgel L. E. Electronic properties of transition metal oxides. I. Distortions from cubic symmetry.—Phys. and Chem. Solids, 1957, 3, No. 1—2, 20—29 (英文)
过渡金属氧化物的电子性质. I. 立方对称的畸变
- 0224 Dunitz J. D., Orgel L. E. Electronic properties of transition - metal oxides. II. Cation distribution amongst octahedral and tetrahedral sites.—Phys. and Chem. Solids, 1957, 3, No. 3—4, 318—323 (英文)
过渡金属氧化物的电子性质. II. 八面体和四面体位置间阳离子的分布
- 0225 Dzurus Marceline L., Hennig Gerhart R. Properties of the Interstitial compounds of graphite. IV. Properties of *n*-type compounds.—J. Chem. Phys., 1957, 27, No. 1, 275—281 (英文)
石墨的间隙式化合物的性质. IV. *n*型化合物的性质
- 0226 Edmond J. T., Broom R. F., Cunnell. The properties of gallium arsenide.—Rept. Meet. Semi-conduct. Phys. Soc. 1956, London, s. a., 109—117 (英文)
砷化镓的性质
- 0227 Eley D. D., Parfitt G. D., Perry M. J., Taysum D. H. The semiconductivity of organic substances. Part 1.—Trans. Faraday Soc., 1953, 49, No. 1, 79—86 (英文)
有机物质的半导体性质. I
- 0228 Eley D. D., Parfitt G. D. The semiconductivity of organic substances, Part 2.—Trans. Faraday Soc., 1955, 51, No. 11, 1529—1539 (英文)
有机物质的半导体性质. II
- 0229 Elliott G. Spiral etch-pits in germanium.—J. Electron. and Control, 1958, 4, No. 5, 456—457 (英文)
锗中螺旋形的腐蚀坑
- 0230 Ellis S. G. Electrolytic etching at small-angle grain boundaries in germanium.—Phys. Rev., 1955, 100, No. 4, 1140—1141 (英文)
在锗的小角度晶粒间界处的电解腐蚀
- 0231 Ellis Ray C., Jr. Etching of single crystal germanium spheres.—J. Appl. Phys., 1957, 28, No. 9, 1068 (英文)
单晶锗球的腐蚀
- 0232 Ellis R. C. Jr., Wolsky S. P. New etches for germanium.—J. Appl. Phys., 1953, 24, No. 11, 1411—1412 (英文)
锗的新腐蚀剂
- 0233 Epelboin I., Froment M. Sur le contrôle des conditions optima du polissage électrolytique des semi-conducteurs. J. phys. et radium, 1957, 18, No. 3, Suppl., 60—61 (法文)
論半导体的电解磨光的最佳条件的控制
- 0234 Esaki Leo. Properties of thermally treated Germanium Phys. Rev., 1953, 89, No. 5, 1026—1034 (英文)
受热处理的锗的性质
- 0235 Fine M. E. C_p - C_v in silicon and germanium.—J. Chem. Phys., 1953, 21, No. 8, 1427 (英文)
硅和锗中的 C_p - C_v
- 0236 Fine Morris E. Elasticity and thermal expansion of germanium between -195 and 275°C.—J. Appl. Phys., 1953, 24, No. 3, 338—340 (英文)
锗在 -195 至 275°C 之间的弹性和热膨胀
- 0237 Fischer Albrecht. Dunne Halbleiterschichten auf Glas.—Z. Naturforsch, 1954, 9a, No. 6, 508—511 (德文)
玻璃上面的半导体薄层
- 0238 Fischer Gaston. FeSc₂, a semiconductor con-

- aining iron.—*Canad. J. Phys.*, 1958, **36**, No. 10, 1435—1438 (英文)
 FeSe_2 ——一种含铁的半导体
- 0239 Fite Robert C. Germanium, a secondary metal of primary importance.—*Scient. Monthly*, 1954, **78**, No. 1, 15—18 (英文)
 锗——一种首要的回收金属
- 0240 Folberth O. G., Oswald F. Über die Halbleitereigenschaften von Galliumphosphid.—*Z. Naturforsch.*, 1954, **9a**, No. 12, 1050—1051 (德文)
 論磷化鎵的半导体性質
- 0241 Folberth O. G., Schillmann E. Die Dotierung von A^{III} BV Verbindungen mit Elementen der vierten Gruppe des Periodischen Systems.—*Z. Naturforsch.*, 1957, **12a**, No. 11, 943—944 (德文)
 摻入周期表中第 IV 族元素的 A^{III} BV 型化合物的合金
- 0242 Forman Ralph. Properties of pore conductors.—*J. Appl. Phys.*, 1955, **26**, No. 9, 1187 (英文)
 多孔性半导体的性質
- 0243 Fritzsche C. Die Halbleitereigenschaften des ZnAs_2 .—*Ann. Phys.*, 1956, **17**, No. 2—3, 94—101 (德文)
 ZnAs_2 的半导体性質
- 0244 Geballe T. H., Morin F. J. Ionization energies of groups III and V elements in germanium.—*Phys. Rev.*, 1954, **95**, No. 4, 1085—1086 (英文)
 锗中 III 族, V 族元素的电离能
- 0245 Geist D., Preuss E. Atzen und Polieren von Germaniumoberflächen.—*Z. angew. Phys.*, 1957, **9**, No. 10, 526—531 (德文)
 锗表面的腐蚀与磨光
- 0246 Genser Milton Intermetallic semiconductors of group III-V elements.—*Industr. Chemist.*, 1957, **33**, No. 393, 553—556 (英文)
 III-V 族元素的金属間半导体
- 0247 Gobrecht H., Bartschat A. Über die Halbleitereigenschaften von synthetischen Herzenbergit (SnS) Kristallen.—*Z. Phys.*, 1957, **149**, No. 4, 511—522 (德文)
 硫化錫合成晶体的半导体性質
- 0248 Gobrecht H., Hamisch H. Der piezoelectrische Effekt beim Selen.—*Z. Phys.*, 1957, **148**, No. 2, 209—217 (德文)
 硒的压电效应
- 0249 Goldberg Arthur E., Michell George R. Occurrence of natural p - n junctions in lead selenide.—*J. Chem. Phys.*, 1954, **22**, No. 2, 220—222 (英文)
 硒化鉛中的天然的 p - n 結
- 0250 Golling E. Spektralanalytische Untersuchungen der Ausgangssubstanzen für halbleitende A^{III} BV .—*Z. Naturforsch.*, 1956, **11a**, 6, 259—263 (德文)
 A^{III} BV 型半导体化合物原始組分的光譜分析研究
- 0251 Gomišček Sergej. Prilog poznavanju silicija.—*Elektro'chn. vesn.*, 1953, **7**, No. 11—12, 332—335 (斯洛凡文)
 硅性質的应用
- 0252 Goodman C. H. L. The prediction of semi-conducting properties in inorganic compounds.—*Phys. and Chem. Solids*, 1958, **6**, No. 4, 305—314 (英文)
 无机化合物中的半导体性質的預測
- 0253 Goodman C. H. L., Douglas R. W. New semi-conducting compounds of diamond type structure.—*Physica*, 1954, **20**, No. 11, 1107—1109 (英文)
 具有金刚石型結構的新的半导体化合物
- 0254 Graf Ludwig, Lacour Hanns-Reiner, Seiler Karl Plastische Verformbarkeit des Germaniums bei höheren Temperaturen.—*Z. Metallkunde*, 1953, **44**, No. 3, 113 (德文)
 锗在高温条件下的范性形变
- 0255 Granato A., Truell R. Frequency dependence of ultrasonic attenuation in germanium.—*J. Appl. Phys.*, 1956, **27**, No. 10, 1219—1226 (英文)
 锗中超声衰减对频率的相依性
- 0256 Grandsen Max M. Ultra-pure solids for electronics.—*Canad. Metals*, 1955, **18**, No. 9, 26, 28—29 (英文)
 供电子学用的超純固体
- 0257 Günther K. G. Aufdampfschichten aus halbleitenden III-V-Verbindungen.—*Z. Naturforsch.*, 1958, **13a**, No. 12, 1081—1089 (德文)
 半导性的 III-V 族化合物的蒸发层
- 0258 Haasen P. On the plasticity of germanium and indium antimonide.—*Acta metallurgica*, 1957, **5**, No.